

PICOSUN™ R-200標準型

PICOSUN™ R-200標準ALD系統適用於IC元件、MEMS元件、顯示器、LED、雷射及鏡片、光學器件、珠寶、硬幣和醫療植入器械等3D物件等的研發。



PICOSUN™ R-200標準ALD系統是全球市場上熱反應原子層沉積(ALD)研究工具的引領者。它已成為創新型公司和研究機構的首選。

該系統設計靈活，確保沉積ALD薄膜的高品質，同時超級靈活的系統組態配置能滿足未來各種需求和應用。經專利註冊的熱腔壁設計、完全獨立的前驅物管線和顯示使得無顆粒沉積廣泛應用於晶片、3D物件和所有奈米尺度的材料。即使在最具挑戰性的多孔材料、超高深寬比和奈米顆粒表面沉積，系統都能實現極好的均勻性，這些都歸功於我們的專利技術Picoflow™。該系統配備功能強大和易於更換的液態、氣態和固態前驅物。系統可整合手套箱、粉末反應腔和各種即時分析系統，讓您的研究變得高效靈活，取得良好成果，不論您的研究領域是什麼，或未來產生何種變化！

技術特徵

典型基板尺寸和類型

- 50到200 mm單片
- 156 mm x 156 mm太陽能矽晶片
- 3D物件
- 粉末和顆粒
- 小批量
- 多孔、穿孔和高深寬比（最高達1:2500）基板

製程溫度

- 50到500°C

典型製程

- Al_2O_3 、 TiO_2 、 SiO_2 、 Ta_2O_5 、 HfO_2 、 ZnO 、 ZrO_2 、 TiN 、 AlN 及Pt或Ir等金屬

基板裝載

- 用氣動升降機手動裝載
- 帶磁機械臂的裝載鎖定室

前驅物

- 液態、固態、氣態和臭氧
- 4根獨立前驅物管線，最多可載入6個前驅物

選配

- Picoflow™ 擴散增強器、RGA、 N_2 產生器、尾氣處理器、定製設計及手套箱相容（用於惰性氣體裝載）

頂級ALD系統滿足應用需求

如欲瞭解更多資訊或報價，請隨時聯繫我們。

picosun
AGILE ALD

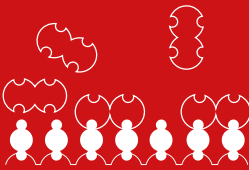
ALD的原理



引入含A元素的分子。



表面吸附分子。



引入含B元素的分子，
與表面的A元素反應。



形成AB化合物單分子層。

重複該過程，直至薄膜厚度符合預期。

picosun
AGILE ALD

PICOSUN總部

Picosun公司

地址：Tietotie 3

FI-02150 Espoo, Finland

電話：+358 50 321 1955

電子郵件：info@picosun.com

Picosun公司

地址：Masalantie 365

FI-02430 Masala, Finland

電話：+358 50 321 1955

電子郵件：info@picosun.com

PICOSUN分公司

Picosun（歐洲）有限責任公司

電話：+49 1522 449 49 11

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（美國）有限責任公司

電話：+1 214 790 0844

手機：+1 214 490 3951

電子郵件：sales@picosun.com

新加坡Picosun（亞洲）有限公司

電話：+65 9756 3265

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（臺灣）有限公司

電話：+886 90 515 2985

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（中國）有限公司

電話：+358 40 480 3449

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（日本）有限公司

電話：+81 3 6431 9500

手機：+81 90 5198 8131

電子郵件：sales@picosun.com